# Status of Superconducting Cavity Development for ERL Main Linac

Masaru Sawamura<sup>1,A)</sup>, Kensei Umenori<sup>B)</sup>, Takaaki Furuya<sup>B)</sup>, Shogo Sakanaka<sup>B)</sup>,

Takeshi Takahashi<sup>B)</sup>, Hiroshi Sakai<sup>C)</sup>, Kenji Shinoe<sup>C)</sup>

<sup>A)</sup> Japan Atomic Energy Agency

2-4 Shirakata-Shirane, Tokai, Ibaraki 319-1195

<sup>B)</sup> High Energy Accelerator Research Organization

1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801

<sup>C)</sup> The Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo

5-1-5 Kashinoha, Kashiwa, Chiba 277-8581

#### Abstract

We have been developing 1.3GHz superconducting cavities for the main linac of the energy recovery linac. The cavities were designed to enhance the HOM properties. Three types of Nb cavities, two single-cell and a 9-cell, have been fabricated to verify the cavity design. The results of 2K vertical test for the single-cell cavities have satisfied the requirement for the ERL main linac.

# ERL用超伝導主加速器開発の現状

## 1. はじめに

エネルギー回収型リニアック(ERL)は、リニアッ クと蓄積リングの長所を合わせ持ち、高輝度かつ大 電流の電子ビームを生成できることから、次世代放 射光源として期待されている。ERLの実現には、高 輝度大電流を生成できる電子銃(入射器)および大電 流を安定に加速できる超伝導空洞の開発が重要な技 術課題としてある。

ERLのような超伝導空洞を用いた大電流のCW加速 器においては高調波(HOM)の減衰が重要である。HOM のQ値を低くすることは、冷凍機システムの負荷を 軽減するだけでなく、ビーム不安定性により制限さ れるしきい値電流の増加を可能にする。

ERL放射光源建設のために、原子力機構、高エ ネルギー加速器研究機構、東大物性研が共同で超伝 導主加速器の開発を行っており、HOM対策に重点を 置いた新たな空洞設計を行い、その性能を検証する ために3種類のニオブ製空洞を製作し、性能試験を 行ってきた。

本報告ではこれまでの試験結果を中心に超伝導主加速器開発の現状を報告する。

## 2. 超伝導主空洞の設計

HOM対策に重点を置いた新しい超伝導空洞設計の 基本方針は

- 1. 加速モードのシャントインピーダンスは出来る だけ高くすること
- 2. 単極モードは2.6GHzの逓倍から離すこと
- 3. 双極モードは出来るだけ抑制すること
- 4. 四重極モードも抑制すること

である。

- 新たな空洞設計は
- 1. 空洞形状を最適化する
- 2. 大口径ビームパイプを用いる
- 3. 偏心フルート型ビームパイプを用いる[1]

とした。超伝導空洞の代表としてTESLA型空洞があ るが、このTESLA型空洞の形状をそのまま用いて ビームパイプを太くした空洞でも、TESLA型空洞に 比べてHOMインピーダンスを1桁近く下げることがで き、双極モードに対する基準は満たせるが、製作誤 差等を考えた場合、余裕が十分とはいえない。そこ でERLに最適な空洞形状設計を行った。TESLA型空洞 からの主な変更部分は

 ①アイリス径をφ70からφ80に大きくしたこと
②赤道部分の形状を円形から楕円形にしたこと
③ビームパイプ径をインプット・カップラー側でφ 100、反対側でφ120としたこと

である。この形状により、双極モードのインピーダ ンスを更に1桁下げることができた[2]。ビーム不安 定性のシミュレーションコードBBU-RおよびBIによ る計算から、600mAの加速が可能との結果を得た[3]。 この値は、HOM周波数がすべてそろっている場合の 計算結果であり、空洞製作誤差等によりHOMの周波 数はランダムに分散するので、実際はもっと大きな しきい値が期待できる。

## 3. Nb空洞の製作

新しい設計に基づく空洞形状の性能を検証するために、以下の3種類のニオブ製空洞を製作した。

① センターセル単空洞(C-single空洞、Fig.1左)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: sawamura.masaru@jaea.go.jp



Fig.1 製作した3種類のNb空洞。(左)センターセル単空洞、(中)エンドセル単空洞、(右)9セル空洞

センターセル形状の単セルにアイリス径のビーム パイプを取り付けたもので、空洞形状に起因する Multipactoringの有無などのセル形状を検証ととも に、表面処理過程を確認する。

② エンドセル単空洞(E-single空洞、Fig.1中)

エンドセル形状の単空洞に大口径ビームパイプを 取り付け、偏心フルート、Input Couplerポートや Pickupポートの構造物を配置し、これらの構造物が 発熱やfield emission等の要因になっていないかを 検証する。

9セル空洞 (Fig.1右)

ERL主加速器に想定している9セル空洞で、プリ チューニングや空洞の取り扱いなどモジュール化す るときの問題点を洗い出す。

#### 4. 表面処理

**C-single**および**E-single**空洞に行った表面処理工 程は以下の通りである。

4.1 C-single空洞(1回目)

①バレル研磨

バレル研磨のメディアGCT12×12と水を空洞体積 の半分ほど入れ、公転速度120rpmで10時間研磨をし た。研磨量はセル部分で64 $\mu$ m、ビームパイプ部分 で18 $\mu$ m程度であった。

②プレ電解研磨

バレル研磨後の空洞内部の汚れでEP液(濃硫酸: フッ酸=10:1)を汚染させないためにEP液を溜め込 んだ状態で電解研磨を行う。空洞温度が上がり過ぎ ないように研磨、冷却を繰り返し、約10μm研磨し た。

#### ③電解研磨

空洞内面の粗さを削り、滑らかな内面にする。EP 液を空洞からリザーバータンクに還流してEP液の温 度制御を行う。約100μmの研磨を行った。

④アニール

電解研磨のとき発生する水素はニオブ材に吸蔵さ れ、Q値の低下をもたらす水素病の原因となるため、 水素脱ガスのためにアニールを行う。真空炉の中で 空洞を750℃3時間加熱した。

⑤仕上げ電解研磨

前回の電解研磨後に空洞内表面にできた不純物を 取り除く。水素吸蔵を起こさない程度の研磨量とす る。今回は20 µ m研磨した。

⑥超音波洗浄

⑦超純水高圧洗浄

空洞内面に残ったミクロな埃を取り除くために、

超純水(18MΩ)をノズルから高圧(8MPa)で噴 出させ、空洞内面を隈なく洗い流す。 ⑧組立て

KEKのSTF棟のClass4のクリーンルーム内 でRFカップラーや真空排気ポートを取り付けたフ ランジを空洞に取り付ける。真空シールにはインジ ウムを用いた。

⑨ベーキング

空洞内面を脱ガスし、高真空にするためヒーター で空洞温度を上げる。真空シールであるインジウム が取り付けられているフランジ近辺の温度は80℃以 下になるように調整する。セル部分で130℃12時間 のベーキングを行った。

⑩縦測定

KEKのD10棟のクライスタットを用いて4K及び2Kでの空洞性能の測定を行った。

4.2 C-single空洞(2回目)

①縦測定

第1回目の縦測定から処理を行わず縦測定をもう1 度行った。

4.3 E-single空洞(1回目)

①バレル研磨

C-single空洞と条件を変え、新東エコメディア DHT15×15を用いた乾式バレル研磨を試みた。80rpm の公転速度で12時間研磨を行った。研磨量は約10 $\mu$ mと、湿式に比べてかなり少ない結果となった。

②プレ電解研磨~縦測定はC-singleと同様の処理を 行った。

4.4 E-single空洞(2回目)

①ベーキング

表面処理を行わずベーキングのみで空洞性能が改 善するかを調べる。

②縦測定

Input Couplerプローブが一連の作業中に折れ曲がり不調となったため測定できず。

4.5 E-single空洞(3回目)

①Input Coupler取替え

不調のInput Couplerのプローブを新品と交換。 ②ベーキング

③縦測定

4.6 E-single空洞(4回目)



ig.2 単空间の縦例と福来。 (上)C-single空洞、(下)E-single空洞。

①仕上げ電解研磨

空洞性能が改善しないため追加の仕上げ電解研磨 を30μm行った。

②超音波洗浄~縦測定はこれまでと同様.

## 5. 単セル空洞の測定結果

ー連の表面処理を終え、C-single空洞は2回、Esingleは4回の縦測定を行った。その結果をFig.2に 示す。

C-single空洞に関しては1回目と2回目の間で表面 処理は行わなかった。1回目と2回目でほぼ同じ結果 となり最大加速電界は37MV/mである。ただしこの値 は空洞性能に起因するものではなく、液体ヘリウム を2Kに冷却するための減圧ポンプの容量が小さく、 空洞温度が上昇してしまうことによるリミットで あった。またQ<sub>0</sub>が10<sup>10</sup>以上の場合の最大加速電界は 25MV/mであった。

E-single空洞に関しては1回目の測定において最 大加速電界は23MV/mであり、field emissionによる クエンチが最大電界を制限していた。そこで、ベー キングのみを行い、空洞性能が改善するかを検証す るため2回目の縦測定を行った。しかし、一連の作 業中にInput Couplerを壊してしまい測定すること ができなかった。そこでinput Couplerを交換し、 ベーキングを行って3回目の縦測定を行ったが、最 大加速電界15MV/mと1回目の測定より大幅に性能が 低下した。そこで仕上げ電界研磨から表面処理をや り直し、4回目の縦測定を行い、最大加速電界 30MV/m、Q<sub>0</sub>が10<sup>10</sup>以上で23MV/mを得た。



Fig.3 回転MappingによるX線出力例(加速電 界20MV/m)。

E-single空洞の測定には空洞診断用に空洞温度や field emissionで空洞に衝突した電子が発生させる X線を検出するセンサーが空洞外面の軸方向に沿っ て取り付けられている。これらのセンサーを空洞の 円周方向に回転させることにより熱とX線の発生場 所を調べる[4]。このシステムを用いた測定で加速 電界20MV/mのときX線の発生を検知したが(Fig. 3)、 発生場所はビームパイプの偏心フルートやInput Couplerポートなどの場所ではなく、ビームパイプ 構造による由来するfield emissionは発生していな いものと考えられる。

### 6.9セル空洞の現状

昨年度9セル空洞も完成し、現在までに電界研磨、 アニール、プリチューニング、仕上げ電界研磨、フ ランジ類の組立、ベーキングなど一連の表面処理が 終了している。今後縦測定のための配線作業等を行 い9月頃に最初の縦測定を行う予定である。

## 7.まとめ

 $Q_0$ が10<sup>10</sup>以上で加速電界が15~20W/mというERL主 加速器に要求される性能はC-single空洞、E-single 空洞共に満たしており、ERL主加速器用に行った空 洞設計には問題がないことが確認された。今後9セ ル空洞の縦測定を行うとともに、Input Couplerや HOM吸収体の設計、試作試験を行っていく予定であ る。

## 参考文献

- M. Sawamura et al., Proc. of PAC07, Albuquerque, USA, June 2007, p.1022
- [2] K. Umemori et al., Proc. of APAC07, Indore, India, Jan. 2008, p.570
- [3] R. Hajima et al., Proc. of ERL07, Daresbury, UK, May 2007, to be published
- [4] H. Sakai et al., Proc. Of EPAC08, Genoa, Italy, June 2008, to be published